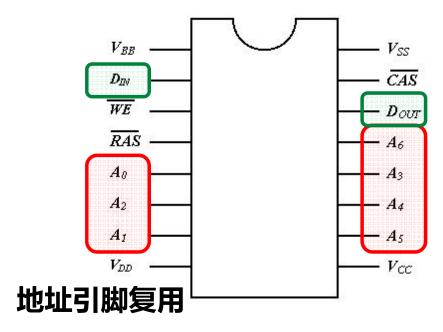


5.1.4 随机存取存储器RAM (二)

Random Access Memory



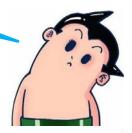
TMS4116动态MOS存储器芯片



TMS4116 引脚图

存储容量多大?

存储容量 = 214×1位

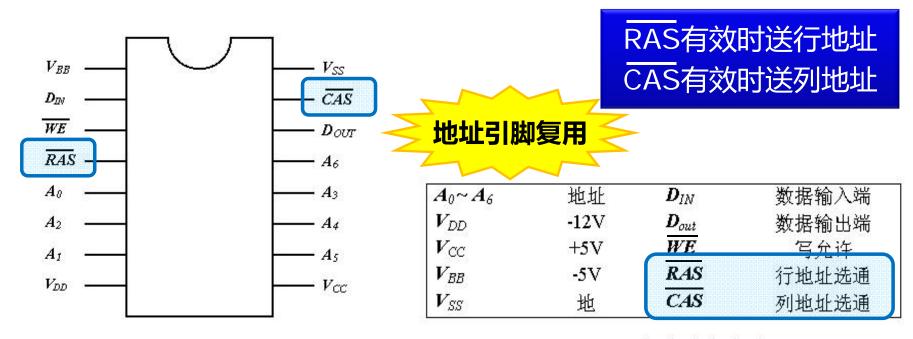


$A_0 \sim A_6$	地址	\boldsymbol{D}_{IN}	数据输入端
V_{DD}	-12V	$oldsymbol{D}_{out}$	数据输出端
$V_{\rm CC}$	+5V	\overline{WE}	写允许
V_{BB}	-5V	RAS	行地址选通
$oldsymbol{V}_{SS}$	地	CAS	列地址选通

TMS4116 芯片引脚名称



TMS4116动态MOS存储器芯片



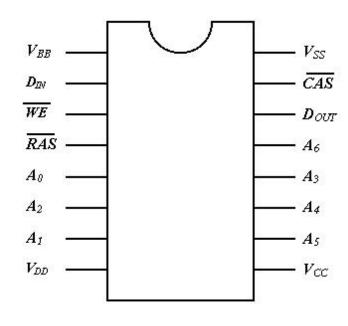
TMS4116 引脚图

TMS4116 芯片引脚名称

计算机原理-

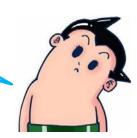


TMS4116动态MOS存储器芯片



TMS4116 引脚图

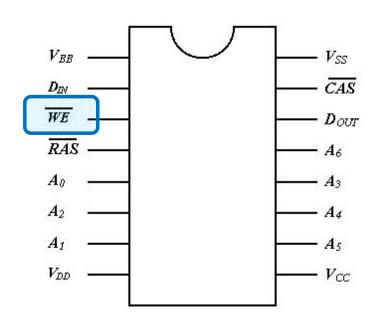
CPU传送到TMS4116 芯片的地址有几位?



- CPU传送到4116有14位地址
- CPU送出的地址位数由物理空间 大小决定



TMS4116动态MOS存储器芯片



TMS4116 引脚图

WE含义是什么?



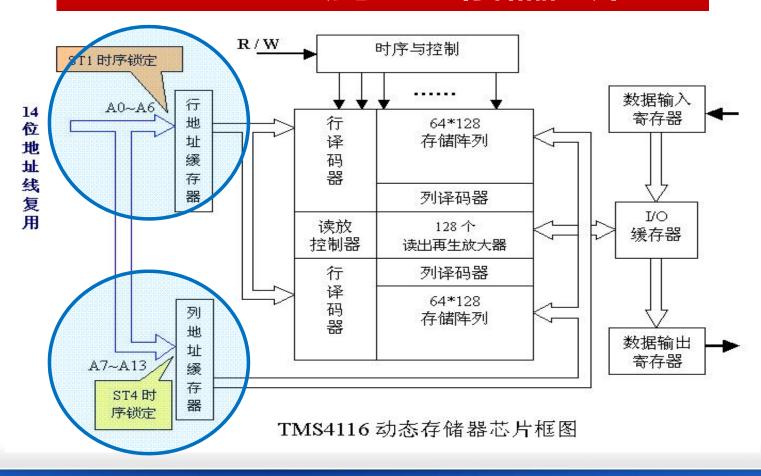
WE低时写操作,高时读操作

$A_0 \sim A_6$	地址	\boldsymbol{D}_{IN}	数据输入端
V_{DD}	-12V	$oldsymbol{D}_{out}$	数据输出端
$V_{ m CC}$	+5V	\overline{WE}	写允许
V_{BB}	-5V	RAS	行地址选通
$oldsymbol{V}_{SS}$	地	CAS	列地址选通

TMS4116 芯片引脚名称



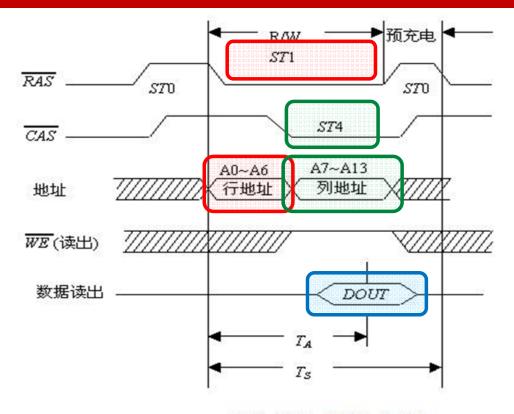
TMS4116动态MOS存储器芯片



计算机原理一



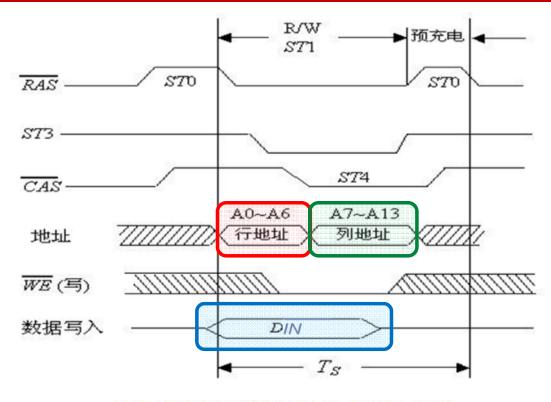
TMS4116动态MOS存储器芯片



TMS4116 芯片读出操作定时



TMS4116动态MOS存储器芯片



TMS4116 芯片写入操作定时



SRAM和DRAM存储器的特性

	DRAM	SRAM
存储原理	电容	触发器
集成度	高	低
芯片引脚	少	多
速度	慢(10X)	快(1X)
价格	低(1X)	高(100X)
刷新	有	无
应用	主存、帧缓冲区	高速缓存存储器

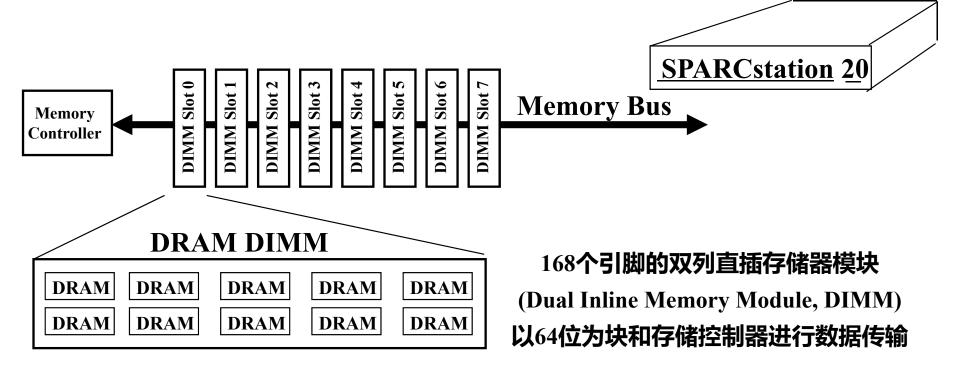








存储器模块(Memory Module)



每次访存操作总是在某一个内存条内进行!

计算机原理-

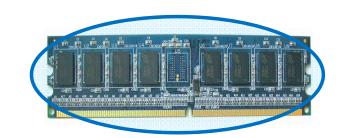


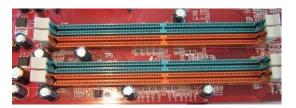
PC机主存储器的物理结构

主存储器由若干内存条组成内存条(存储模块)的组成

• 把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成

内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用





目前主流的是DDR3内存条

- 双倍数据速率同步DRAM(Double Data-rate Synchronous DRAM, DDR SDRAM)
- 采用双列直插式,其触点分布在内存条的两面
- PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽

